

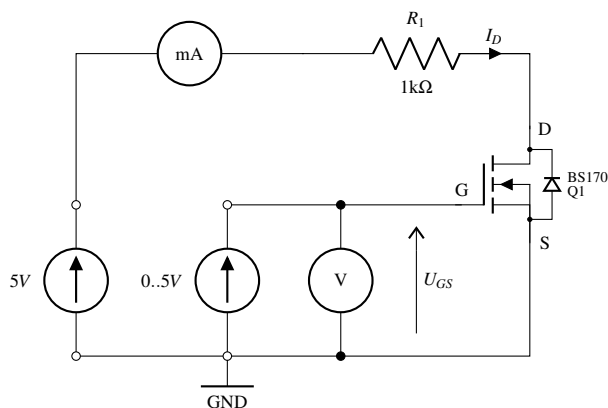
Laboratorium Podstaw Elektroniki			
Kierunek <i>Informatyka</i>	Specjalność —	Rok studiów <i>I</i>	Symbol grupy lab. <i>II</i>
Temat Laboratorium <i>Tranzystory</i>			Numer lab. <i>5</i>
Skład grupy ćwiczeniowej oraz numery indeksów <i>Ewa Fengler(132219), Sebastian Maciejewski(132275), Jan Techner(132332)</i>			
Uwagi		Ocena	

Cel

Celem przeprowadzanych ćwiczeń jest zapoznanie się z właściwościami tranzystora MOSFET jako elementu elektronicznego w układach prądu stałego oraz zmiennego.

1 Zadanie 1.5

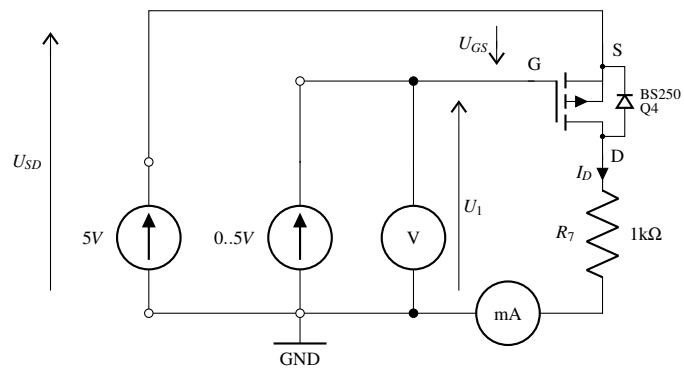
1.



Rysunek 1: Obw. 1.6 Układ do badania charakterystyki bramkowej tranzystora nMOS

2.

Pomiary prądu drenu I_D w zależności od napięcia bramka - źródło U_{GS} z uwzględnieniem szczególnej wartości U_{GS} , przy której gwałtownie wzrasta natężenie prądu.



Rysunek 2: Obw. 1.7 Układ do badania charakterystyki bramkowej tranzystora pMOS

$U_{GS}[V]$	$I_d[mA]$
0	0
0,5	0
1	0
1,9	0,16
2	0,57
2,1	2,07
2,2	3,17
2,3	4,95
2,4	5,02
2,5	5,03
3	5,05
3,5	5,05
4	5,05
4,5	5,06
5	5,06

3.

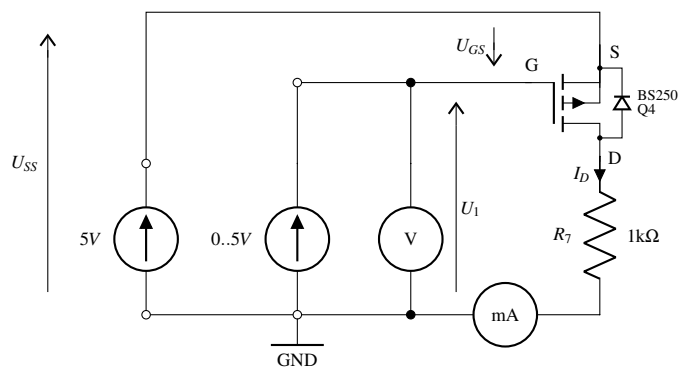
[wykres]

5.

[wnioski]

2 Zadanie 1.6

1.



Rysunek 3: Obw. 1.7 Układ do badania charakterystyki bramkowej tranzystora pMOS

2.

Pomiary prądu drenu I_D w zależności od napięcia źródła U_1 z uwzględnieniem szczególnej wartości U_1 , przy której gwałtownie wzrasta natężenie prądu. Dla wszystkich pomiarów obliczone zostało także napięcie bramka - źródło U_{GS} na podstawie napięciowego prawa Kirchhoffa, ze wzoru $U_{GS} = -(U_{SS} - U_1)$.

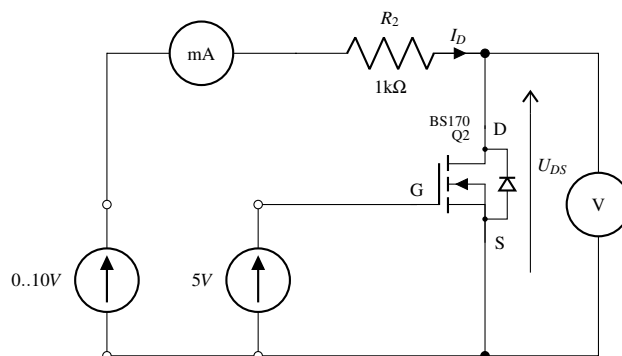
$U_1[V]$	$I_D[mA]$	$U_{GS}[V]$
0	5,04	-5
0,5	5,03	-4,5
1	5,01	-4
1,5	4,9	-3,5
1,6	2,09	-3,4
1,7	1,36	-3,3
1,8	0,57	-3,2
1,9	0,27	-3,1
2	0,08	-3
2,5	0	-2,5
3	0	-2
3,5	0	-1,5
4	0	-1
4,5	0	-0,5
5	0	0

3.

[WYKRES]

3 Zadanie 1.7

1.



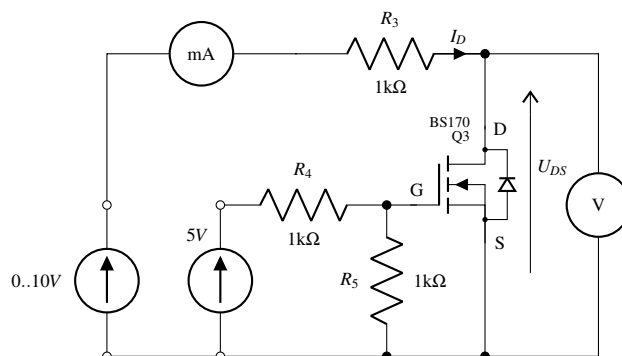
Rysunek 4: Obw. 1.8 Układ do badania charakterystyki drenowej tranzystora nMOS

2.

Napięcie bramka-źródło $U_{GS} = 5,05V$

$U_{DS}[mV]$	$I_d[mA]$
0	0
3,2	1,16
6,1	2,23
8,7	3,14
11,3	4,15
14,0	5,18
16,7	6,19
19,4	7,19
22,2	8,19
25	9,24
27,9	0,29

3.



Rysunek 5: Obw. 1.9 Układ do badania charakterystyki drenowej dla obniżonego napięcia bramki

4.

Napięcie bramka-źródło $U_{GS} = 2,52V$ (mV?)

$U_{DS}[mV]$	$I_D[mA]$
0	0
12,7	1,17
24	2,12
37,6	3,16
52,3	4,14
68,8	5,10
89,6	6,10
116,3	7,12
150,1	8,06
205	9,09
298	9,94

5.

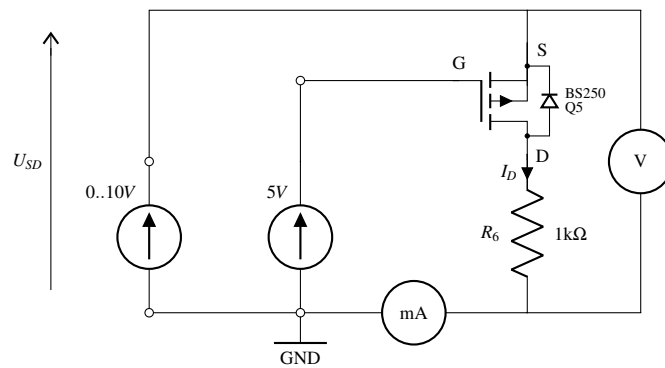
[WYKRES]

6.

[WNIOSKI]

4 1.8

1.



Rysunek 6: Obw. 1.10 Układ do badania charakterystyki drenowej tranzystora pMOS

2.

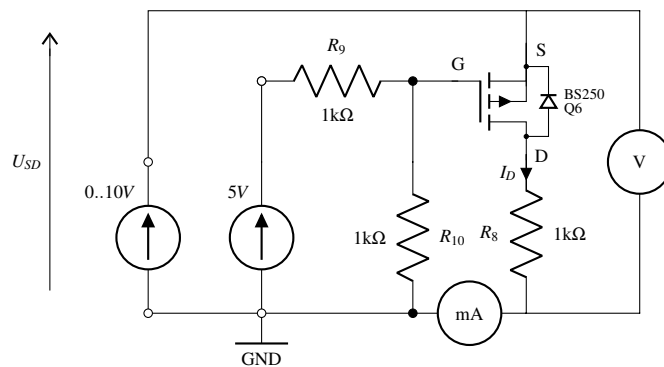
napięcie Bramki U_{GS} : -5,05V

źródło?	$U_{DS}[V]$	$I_D[mA]$
1	-1,12	0
2	-2,15	0
3	-3,15	0
4	-4,24	0
5	-5,25	0
6	-6,16	0
7	-6,92	0,22
7,5	-1,46	6,15
8	-0,1	8,13
9	-0,07	9,20
10	-0,07	10,18

3.

4.

napięcie Bramki U_{GS} : UZUPEŁNIĆ!



Rysunek 7: Obw. 1.11 Układ do badania charakterystyki drenowej dla obniżonego napięcia bramki pMOS

źródło?	$U_{DS}[V]$	$I_D[mA]$
1	-1,13	0
2	-2,18	0
3	-3,18	0
4	-4,16	0
4,5	-4,35	0,3
5	-0,27	4,95
6	-0,05	6,14
7	-0,05	7,19
8	-0,05	8,17
9	-0,06	9,2
10	-0,06	10,21

5.

[WYKRES]

6.

[WNIOSKI]

5 Zadanie ?

[OBWÓD 1.14]

6 Zadanie ?

[OBSERWACJA]

7 Zadanie ?

[OBWÓD 1.15]

8 Zadanie ?

[OBSERWACJA, WNIOSKI]

9 Zadanie ?

[OBWÓD 1.17]

10 Zadanie ?

[zdjęcia, obserwacja, wpływ na diodę]

11 Zadanie ?

[zdjęcia, dla jakiej częst. : 1,13MHz]

Literatura

[1] W trakcie przeprowadzania doświadczeń i pisania sprawozdania zespół korzystał głównie z materiałów ze strony <http://mariusznaumowicz.ddns.net/materialy.html> oraz z wiedzy własnej.